

28Gbaud InGaAs PIN PD Chip $\phi 18\mu\text{m}$



产品描述

InGaAs PIN 高速光探测器芯片

产品特点

$\phi 18\mu\text{m}$ 有效面积；高响应度；GSG 电极结构

应用领域

IEEE 200Gbps Ethernet | 光纤数据通信



021-56461550



021-64149583

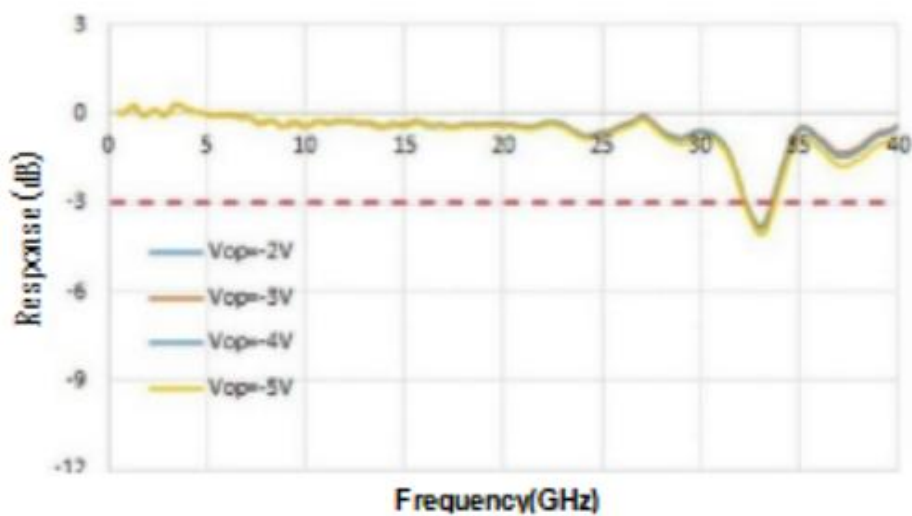


info@microphotons.com



www.microphotons.com

详细参数



规格 ($T_c=25^{\circ}C$, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ	900		1650	nm	
响应度	R	0.8	0.9		A/W	$\lambda=1310-1550nm$
暗电流	I_D		0.01	0.1	nA	$V_R=-5V$
电容	C		0.06	0.10	pF	$V_R=-2V, f=1MHz$
带宽	Bw		25		GHz	$V_R=-2V$ 3dB down, $R_L=50\Omega$
有效区直径	D		18		μm	
通道之间的中心间距(pitch)			250		μm	